

PNP SILICON AMPLIFIER TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/357

Devices

2N3634	2N3635	2N3636	2N3637
2N3634L	2N3635L	2N3636L	2N3637L

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

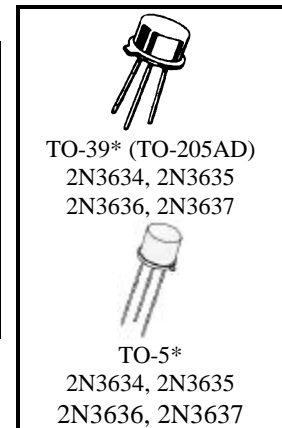
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3634* 2N3635*	2N3636* 2N3637*	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	140	175	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	140	175	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0		Vdc
Collector Current	I_C	1.0		Adc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = +25^{\circ}C^{(1)}$	1.0	W
		@ $T_C = +25^{\circ}C^{(2)}$	5.0	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}C$

*Electrical characteristics for "L" suffix devices are identical to the "non L" corresponding devices

1) Derate linearly 5.71 mW/ $^{\circ}C$ for $T_A > +25^{\circ}C$

2) Derate linearly 28.6 mW/ $^{\circ}C$ for $T_C > +25^{\circ}C$



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Current $I_C = 10$ mAdc	2N3634, 2N3635 2N3636, 2N3637	$V_{(BR)CEO}$	140 175	Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 100$ Vdc $V_{CB} = 140$ Vdc	2N3634, 2N3635	I_{CBO}	100 10	η Adc μ Adc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 3.0$ Vdc $V_{EB} = 5.0$ Vdc		I_{EBO}	50 10	η Adc μ Adc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 100$ Vdc		I_{CEO}	10	μ Adc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS (3)				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 0.1 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 1.0 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 150 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 0.1 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 1.0 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$ $I_C = 150 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	 h_{FE} h_{FE}	25 45 50 50 30 55 90 100 100 60	150 300
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}, I_B = 1.0 \text{ mAdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, I_B = 5.0 \text{ mAdc}$	$V_{CE(sat)}$		0.3 0.6	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}, I_B = 1.0 \text{ mAdc}$ $I_C = 50 \text{ mAdc}, I_B = 5.0 \text{ mAdc}$	$V_{BE(sat)}$	0.65	0.8 0.9	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Forward Current Transfer Ratio $I_C = 30 \text{ mAdc}, V_{CE} = 30 \text{ Vdc}, f = 100 \text{ MHz}$	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	$ h_{fe} $	1.5 2.0	8.0 8.5
Forward Current Transfer Ratio $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	h_{fe}	40 80	160 320
Small-Signal Short-Circuit Input Impedance $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$	2N3634, 2N3636 2N3635, 2N3637	h_{je}	100 200	600 1200 Ω
Small-Signal Open-Circuit Output Admittance $I_C = 10 \text{ mAdc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$		h_{oe}		200 μs
Output Capacitance $V_{CB} = 20 \text{ Vdc}, I_E = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		C_{obo}		10 pF
Input Capacitance $V_{EB} = 1.0 \text{ Vdc}, I_C = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		C_{ibo}		75 pF
Noise Figure $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, I_C = 0.5 \text{ mAdc}, R_g = 1.0 \Omega$	$f = 100 \text{ Hz}$ $f = 1.0 \text{ kHz}$ $f = 10 \text{ kHz}$	NF		5.0 3.0 3.0 dB

SAFE OPERATING AREA

DC Tests				
$T_C = 25^0C, 1 \text{ Cycle}, t = 1.0 \text{ s}$				
Test 1				
$V_{CE} = 100 \text{ Vdc}, I_C = 30 \text{ mAdc}$	2N3634, 2N3635			
$V_{CE} = 130 \text{ Vdc}, I_C = 20 \text{ mAdc}$	2N3636, 2N3637			
Test 2				
$V_{CE} = 50 \text{ Vdc}, I_C = 95 \text{ mAdc}$				
Test 3				
$V_{CE} = 5.0 \text{ Vdc}, I_C = 1.0 \text{ Adc}$				

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2.0\%$.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331